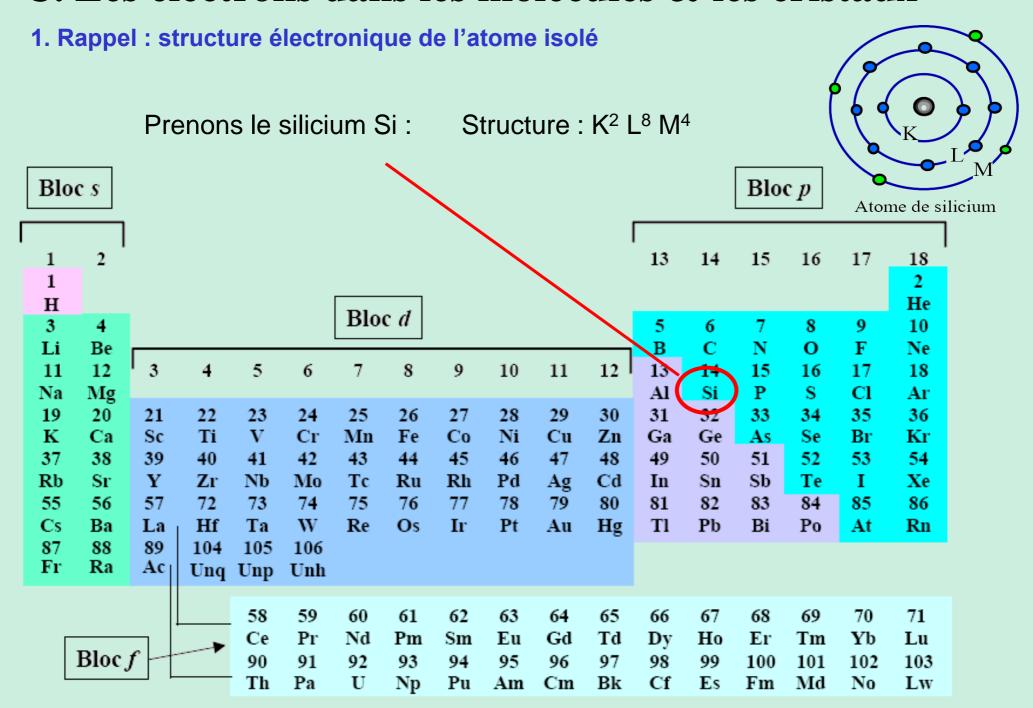
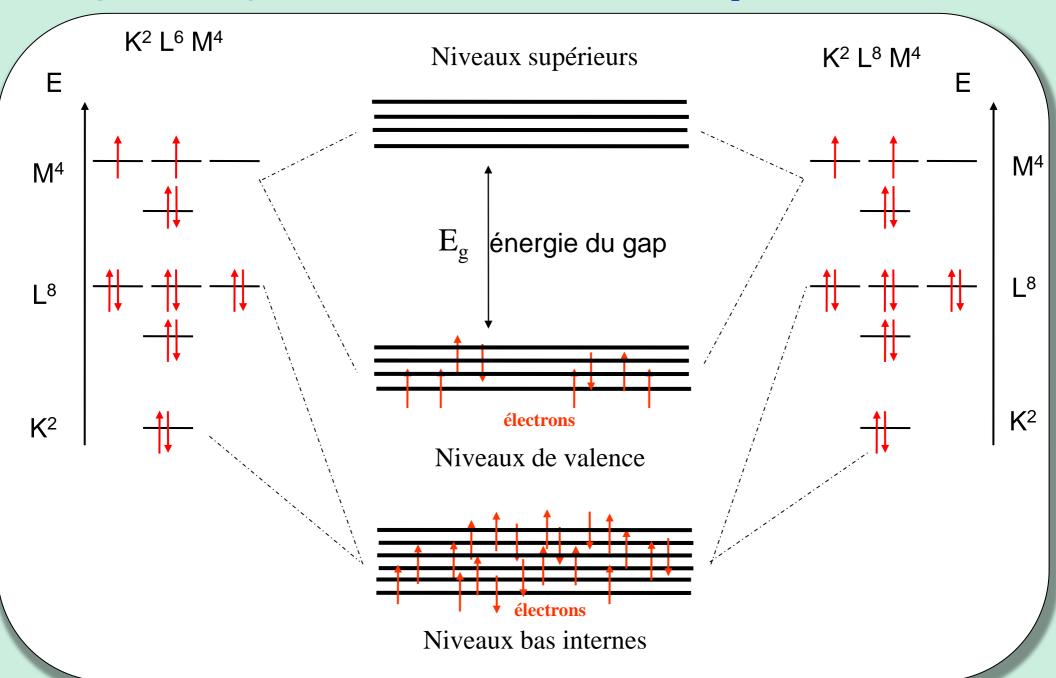
C. Les électrons dans les molécules & les cristaux



3. Diagramme énergétique de 2 atomes de silicium : cas de Si₂



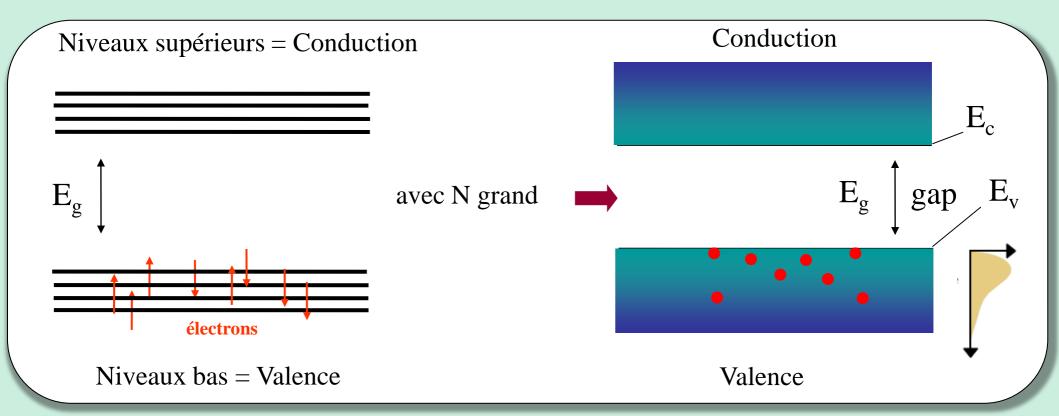
Pour la suite, on « oubliera » les niveaux internes, rarement utiles

4. Diagramme énergétique de N atomes de silicium : le cristal



Système de N orbitales qui se recouvrent Si N grand, les niveaux <u>deviennent indiscernables</u>

Formation de bandes

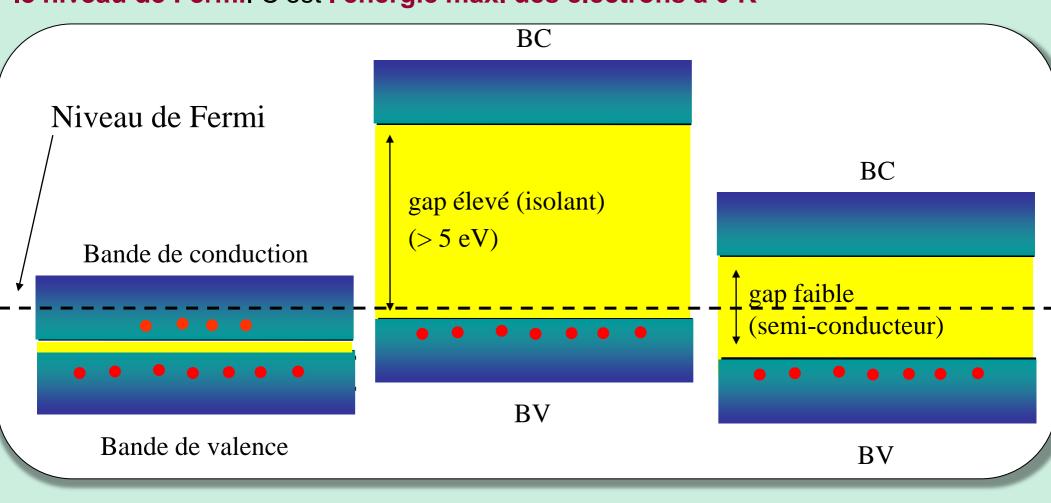


On a vu que le Si contient 5.10²² atomes.cm⁻³ (cristallo).

Si on suppose qu'il y a env. 5 niveaux par atome et si la largeur de la bande fait 5 eV, cela fait $5/5.10^{23} = 10^{-23}$ eV d'écart : **impossible à séparer !**

5. Gap dans les matériaux : conducteur, isolant, semiconducteur a. Les différents matériaux

Chaque matériau cristallin possède un caractéristique propre : le niveau de Fermi. C'est l'énergie max. des électrons à 0 K



gap nul (conducteur)

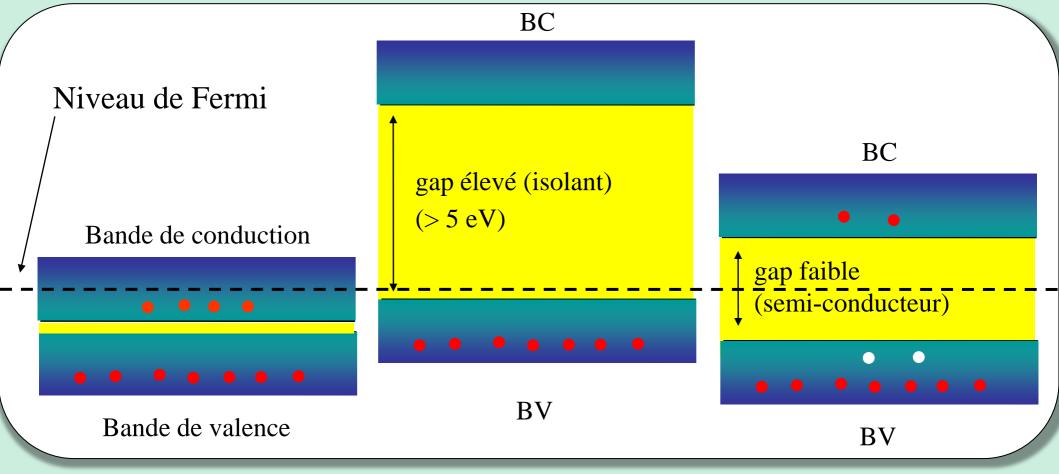
Matériau isolant

Matériau semicon.

Dopé: $E_g < 2 \text{ eV}$

Non dopé : $E_g > 3 \text{ eV}$

Métal



gap nul (conducteur)

Métal

Matériau isolant

Matériau semicon.

Dopé : E < 2 eV

Non dopé : E > 3 eV

Cas métal : tjrs conducteur (électrons dans la BC)

Cas isolant : gap > 5 eV.

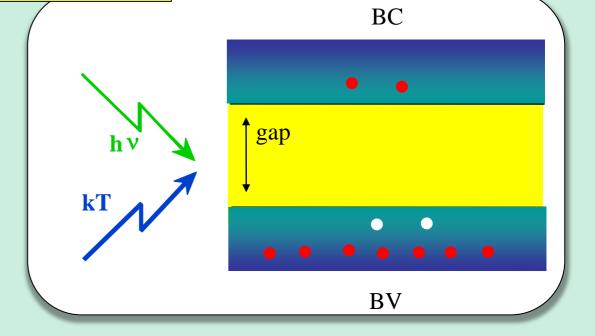
On considère qu'il faut un gap > 200 kT_{ambiante} pour bloquer

Exemples : diamant, $E_g = 5,47 \text{ eV}$; SiO_2 , $E_g = 9 \text{ eV}$ Si, $E_q = 1,12 \text{ eV}$; Ge, $E_q = 0,66 \text{ eV}$

Petit rappel sur les ordres de grandeurs

Les gap des métaux : 0 eV

semicons : < 3 eV isolants : > 5 eV



• Energie thermique

$$E = \frac{1}{2} kT$$

$$kT_{ambiante} = 1,38.10^{-23} \text{ x } 298 = 4,1.10^{-21} \text{ J} = 0,026 \text{ eV}$$

• Energie radiative E = hv = hc / λ

 $h = 6,63.10^{-34} \text{ J.s}$ $v = 418.10^{14} \text{ Hertz}$, soit 620 nm pour E = 2 eV